

Silicon DIAC

BR100/3

28..36V / 2A

DATASHEET

OEM – Valvo

Source: Valvo Datenbuch1983

BR 100/03

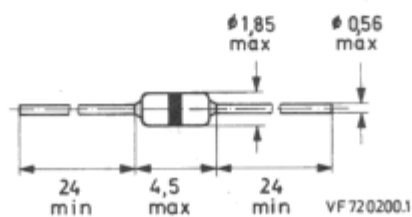
Bidirektionale
SILIZIUM - TRIGGERDIODE (DIAC)
zur Zündung von Thyristoren und Triacs



Durchbruchspannung bei $dU/dt = 10 \text{ V/ms}$	$U_{(BR)} = 28 \dots 36 \text{ V}$
Differenz-Spannung bei $dU/dt = 10 \text{ V/ms}$	$\Delta U > 5 \text{ V}$
Höchstzulässiger periodischer Spitzenstrom, $t \leq 20 \mu\text{s}$	$I_M = 2 \text{ A}$

ABMESSUNGEN in mm

Gehäuse: Glas, \approx JEDEC D0-35



BR 100/03

GRENZWERTE

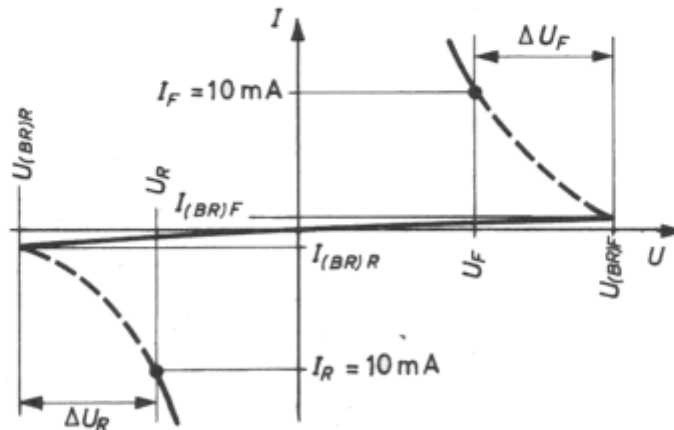
Höchstzulässiger periodischer Spitzenstrom bei $t \leq 20 \mu\text{s}$:	$I_M = 2 \text{ A}$
Höchstzulässige Verlustleistung bei $\vartheta_U \leq 50^\circ\text{C}$:	$P = 150 \text{ mW}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = 100 \text{ }^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich:	$\vartheta_S = -55 \dots +125 \text{ }^\circ\text{C}$

WÄRMEWIDERSTAND

zwischen Sperrschicht und Umgebung:	$R_{th U} = 0,33 \text{ K/W}$
-------------------------------------	-------------------------------

KENNWERTE bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$

Durchbruchspannung bei $dU/dt = 10 \text{ V/ms}$:	$U_{(BR)} = 28 \dots 36 \text{ V}$
Durchbruchstrom bei $0,98 \cdot U_{(BR)}$:	$I_{(BR)} < 100 \mu\text{A}$
Unsymmetrie der Durchbruchspannung:	$ U_{(BR)F} - U_{(BR)R} < 3 \text{ V}$
Differenz-Spannung bei $dU/dt = 10 \text{ V/ms}$:	$\Delta U > 5 \text{ V}$



MESS-SCHALTUNG

für Thyristor-Zündschaltung:

An einem 20Ω - Widerstand anstelle des Thyristor-Steueranschlusses

ist $U_{GM} > 5 \text{ V}$

